FILTRELE OPTICE PENTRU MULTIPLEXOARE ȘI DEMULTIPLEXOARE

Alisa MAŞNIC

Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: Prezentul articol reprezintă cercetarea birefracției și structurii benzilor energetice, a nivelelor excitonice ale materialelor calcopirite $CuAl_xGa_{1-x}Se_2$, pentru determinarea parametrilor nivelelor excitonice. Materialele studiate sunt perfecte pentru realizarea filtrelor de bandă îngustă folosite în dispozitivele optoelectronice. Aceste filtre sunt deosebit de utile spectroscopiei Raman folosind lasere semiconductoare liniile de emisie a cărora sunt destul de largi.

Noțiuni-cheie:Polaritate, spectre de absorbție și reflecție, semiconductori, constantele optice, birefringență.

1. Introducere

Proprietățile de birefringență în cristalele CuGaSe₂ și CuAlSe₂, precum și soluțiile lor solide, care aparțin grupelor semiconductoare I-III-VI₂ se cristalizează într-o structură de calcopirită cu grupul spațial I⁴_{2d}-D¹²_{2d}. Filtrele optice și bateriile solare sunt dezvoltate pe baza acestor materiale [1-4]. Acești compuși posedă o anizotropie puternică a proprietăților optice, atât în domeniul spectral vizibil, cît și în infraroșu.

Caracteristicile spectrale ale indicilor de refracție se intersectează la o anumită lungime de undă λ_0 . La această lungime de undă nu există nici o anizotropie [5-7]. Următoarele lungimi de undă izotrope au fost stabilite: $\lambda_0 = 536$ nm pentru cristalele CuAlSe₂, $\lambda_0 = 642$ nm pentru cristalele de CuGaS₂ [6], $\lambda_0 = 811$ nm pentru cristalele AgGaSe₂ și $\lambda_0 = 810$ nm pentru cristalele de CuGaSe₂ [6, 7]. Spectrele de transmisie a astfel de cristale, măsurate cu polarizatoare orientate perpendicular și axa optică a cristalului orientată paralel la polarizarea unuia dintre polarizatoare, sunt caracterizate printr-o bandă îngustă de transport localizate la lungimea de undă de la punctul izotrop (IP) (adică sistemul funcționează ca un filtru trece bandă) [9-15]. În contrast, o linie subtire de absorbție se observă în același domeniul spectral cu cel al polarizatorului orientat paralel (filtru de rejecție).

2. Detalii experimentale

Cristalele de CuAl_{1-x}Ga_xSe₂ sub formă de placă cu suprafețele de oglindă de dimensiunile 2.5×1.0 cm² și grosimea de 15-600 microni au fost crescute prin metoda transportului din faza de vapori. Suprafețele unor plăci au fost paralele cu axa C. Transmisia optică și spectrele reflexiei au fost măsurate cu un spectrometru dublu SDL-1 (figura 1). Lumina de la o lampă cu halogen a fost concentrată pe un sistem orientat paralel sau pe polarizatoarele barate Glan-Thompson, orientate perpendicular. Un cristal anizotrop a fost plasat între polarizatoare. Probele au fost montate pe stația rece a unui sistem criogenic optic LTS-22 C 330 pentru măsurări la temperatură scăzută.



Figura 1: Schema configurației experimentale

3. Rezultatele experimentale și analiza lor

3.1. Birefringența și lungimea de undă izotropă λ_0 în cristalele de CuAl₁-xGa_xSe₂

Intersecția curbelor de dispersie a indicilor de refracție ordinare n_o și extraordinare n_e este o particularitate a unui cristal uniaxial. Un cristal uniaxial demonstrează comportamentul unui mediu izotrop optic, la $\lambda = \lambda_0$. Lungimea de undă λ_0 se numește "lungimea de undă izotropă" (sau punctul izotrop IP). Un număr mare de cristale, care posedă o lungime de undă izotropă au fost relevate și studiate până în prezent [5-15]. Materialele cu o structură calcopirită posedă o birefracție mai mare în comparație cu cristale cu structura wurtzit-ului (sulfură naturală de zinc).

Excitonul C a fost observat la 2.023 eV (n = 1) și 2.038 eV (n = 2), în aceeași polarizare. Masele de deviere (translation mass) egale cu 1.4m₀ pentru excitonii A și B, și cu 1.0m₀ pentru excitonul C, s-au dedus din calculele contururilor de reflexie [5, 7]. Dependențele spectrale ale indicilor de refracție și a coeficienților de absorbție, precum și parametrii principali ai excitonilor și benzilor de energie, de asemenea, au fost determinate de calcule ale contururilor de reflexie [7]. Masa efectivă a electronului M_c^* , cu M = 1.4m₀ și μ = 0.13m₀ va fi egală cu 0.14m₀, iar masa efectivă a golurilot M_{v1}^* , va fi eaglă cu 1.26m₀. Luând în considerare faptul că parametrii excitonilor Γ_5 diferă nesemnificativ de cele ale excitonilor Γ_4 , masa efectiva M_{v2}^* conform [7], de asemenea, va fi egală cu 1.26m₀, adică practic coincide cu masa M_{v1}^* . Parametrii a excitonilor și benzilor de energie sunt determinate de abrupția caracteristicii spectrale ale indicilor de refracție ale undelor de lumină ortogonal polarizate. Dependența lungimei de undă de tăiere corespunzătoare benzei interzise a substanței solide CuAl_{1-x}Ga_xSe₂ de valoarea x este prezentată în figura 2. Lungimea undei de tăiere la 10K a fost determinată din spectrul de reflexie al excitonului.

Lungimea de undă izotropă este determinată de spectrele de absorbție și analiza datelor din literatură [8]. Dependența spectrală a indicelui de refracție (chenarul înserat în figura 2) se determină din calculele ale conturului experimental a reflexiei spectrelor. Se poate vedea din chenarul din figura 2 că abrupția caracteristicilor spectrale ale indicilor de refracție pentru undele cu polarizările E $\parallel c$ și E $\perp c$ sunt diferite. Indicii de refracție se intersectează la o anumită lungime de undă.



Figura 2: Dependența lungimii de undă de tăiere corespunzătoare benzei interzise, și lungimea de undă izotropă a soluțiilor solide $CuAl_1-xGa_xSe_2$ de valoarea x. Chenarul înserat reprezintă dependența spectrală a indicilor de refracție pentru excitonii Γ_4 în cristalele $CuGaSe_2$.

4. Filtre combinate pe bază de cristale $CuGa_xAl_{1-x}Se_2$

Selectivitatea filtrului depinde de rata schimbării valorii $[\delta n^2 + \Delta n^2]$ în timp ce trece prin punctul izotropic sau, cu alte cuvinte, de abrubția dispersiei frecvenței $n(\lambda)$ și curbele $\delta n(\lambda)$ în vecinătatea λ_0 . Prin atribuirea $\alpha = (d\Delta n/d\lambda)_{\lambda=\lambda_0}$ și $\beta = (d\delta n/d\lambda)_{\lambda=\lambda_0}$ și luând în considerare faptul că, în cristalele cunoscute $\alpha = (10 - 10^{-2})\beta$ [5, 6], se poate deduce că aportul în dependența frecvenței a argumentului în (14) vine de la dispersia lui Δn .



Figura 3. Spectrul de transmisie a cristalului $CuGa_xAl_{1-x}Se_2$ cu x = 0.4 și cu grosimile de 150 și 200 µm măsurat cu polarizatoare orientate paralel.

5. Concluzii

Pentru o aplicare mai largă a filtrelor de bandă îngustă în spectroscopia Raman și în alte domenii de spectroscopie optică, este necesar de selectat compoziția soluției semiconductorului solid cu lungimea de undă izotropică λ_0 în așa mod ca să fie o coincidență între lungimea de undă izotropică și lungimea de undă a liniei de emisie a laserului. Banda de transmisie respectivă ar trebui să fie mai îngustă decât linia laserului. Filtrele cu mai multe benzi înguste în intervalul de lungimi de undă 480-810 nm pot fi fabricate pe bază de soluții solide de $CuGa_xAl_{1-x}Se_2$. Analiza caracteristicilor spectrale ca funcție de grosimea cristalului a demonstrat că filtrul cu $d = \pi/\rho_0$ selectează două linii spectrale. Cu o grosime corespunzătoare se poate obține filtre cu benzi de transmisie multiplă (absorbție).



Figura 4. Filtre optice bazate pe cristalele CuAlSe₂ plasate între polarizatoare orientate paralel (mod de eliminare a benzilor). Grosimea cristalelor este de 15 μm (A) și 270 μm (B).

Lungimile de undă ale acestor linii diferă de la λ_0 , dar ele sunt situate pe laturile lungimilor de undă scurte și lungi a lungimii de undă izotropice. Aceste filtre sunt utile pentru filtrarea radiației de la laserele acordabile. Aceste filtre permit sa măsurăm spectrul Raman cu numărul de unde apropiat liniei laserului, și de a folosi un singur spectrometru în loc de două sau trei. Aceste filtre sunt deosebit de utile spectroscopia Raman folosind lasere semiconductoare liniile de emisie a cărora sunt destul de largi.

Referințe

- 1. Shay J L and Wernick J H 1975 Ternary Chalcopyrite Semiconductors: Growth, Electronic Properties, and Applications (Oxford: Pergamon)
- 2. Birkmire R W and Eser E 1997 Annu. Rev. Mater. Sci. 27 625
- 3. Boyd G D, Kasper H M, McFee J H and Stores G 1972 IEEE J. Quantum Electron. 8 900
- 4. Boyd G D, Kasper H M and McFee J H 1971 IEEE J. Quantum Electron. 7 563
- 5. Horinaka H, Mononobe S and Yamomopto N 1993 Japan. J. Appl. Phys. Suppl. 32-3 109

- 6. Horinaka H, Okudo T and Yamomopto N 1989 Japan. J. Appl. Phys. 28 1328
- 7. Yeh P 1980 Opt. Commun. 35 15 Yeh P 1982 Appl. Opt. 21 4054
- 8. Lotspeich J F, Stephens R R and Henderson D M 1982 IEEE J. Quantum Electron. QE-18 1253
- 9. Horinaka H, Tomii K, Sonomura H and Miyauchi T 1985 Japan. J. Appl. Phys. 24 755
- 10. Horinaka H, Yamamoto N and Hamaguchi H 1992 Appl. Spectr. 46 379
- 11. Horinaka H, Sonomura H and Miyauchi T 1980 Japan. J. Appl. Phys. Suppl. 19-3 111
- 12. Susaki M, Yamomoto N and Horinaka H 1994 Japan. J. Appl. Phys. 33 1561
- 13. Horinaka H, Sonomura H and Miyauchi T 1985 Japan. J. Appl. Phys. 24 463
- 14. Yamomoto T, Takehara H, Horinaka H and Miyauchi T 1986 Japan. J. Appl. Phys. 25 1397